# 单刀双掷开关芯片

#### 关键指标

频率: DC~20GHz 插入损耗: 1.2dB 隔离度: 50dB

电压/电流: -5V/1mA 控制电平: 0, 3.3V~5V 芯片尺寸: 1.25mm×0.95mm

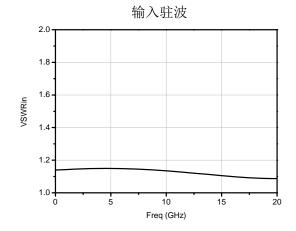
### 产品简介

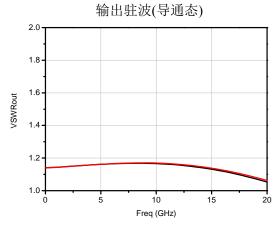
 ${
m HG127KC}$  是一款  ${
m DC}\sim 20{
m GHz}$  吸收式单刀双掷开 关芯片,插入损耗为  $1.2{
m dB}$ ,隔离度为  $50{
m dB}$ 。集成驱 动控制器。

#### 电性能 (TA=25℃, VEE=-5V)

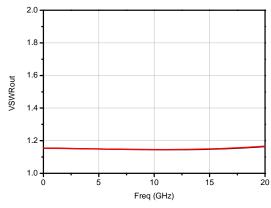
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~20		
输入驻波	_	1.2	-
输出驻波	-	1.2	-
插入损耗(dB)	-	1.2	-
隔离度(dB)	_	50	-
静态电流(mA)	_	1	_

#### 典型测试曲线

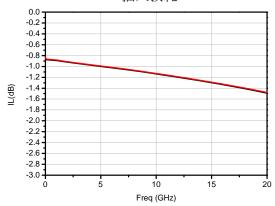




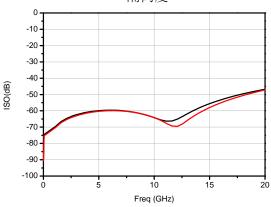
## 输出驻波(关断态)



### 插入损耗



#### 隔离度



#### 开关真值表

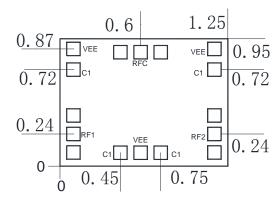
VEE	C1	RFC-RF1	RFC-RF2
-5V	0V	ON	OFF
-5V	5V	OFF	ON

#### 绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm				
工作电压	-5.5V				
控制电压	低电平: 0~0.5V	高电平: 3~5V			
工作温度	-55°C∼125°C				
存储温度	-65℃~150℃				

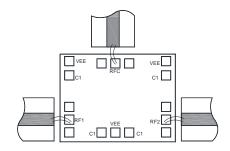
# 单刀双掷开关芯片

### 外形和端口尺寸 (mm)



#### 推荐装配图

注: VEE 加电端与 C1 控制端口各任选 1 个即可。



#### 注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储,在超净环境使用;
- 2. GaAs 材料较脆,不能触碰芯片表面,使用时必须小心;
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过300℃,时间不能超过30秒),使之充分接地;
- 4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合,建议金丝长度 250~400μm;
- 5. 芯片微波端无隔直电容;
- 6. 芯片对静电敏感,在储存和使用过程中注意防静电。